

RF SW SET

MI 301

5W MAX

ADS-1001 400 YEN

V-UHFのRF入出力を高周波スイッチング用ダイオードで切替るものです。約30~1000MHzで使用でき、同軸リレーの代りに低損失切替器として使用できます。電力容量により2つのタイプがあります。

MI301

高周波電力スイッチング用
シリコンエピタキシャルプレーナ形

特長

- PIN構造を有し、VHF、UHF帯での電力スイッチング(公称アンテナ出力~5W)が可能
- アイソレーションが高く、そう入損失が小さい
- 小形、軽量で実装が容易
- ガラス機密封止及びプレーナ構造により信頼性が高い

最大定格(Ta=25℃)

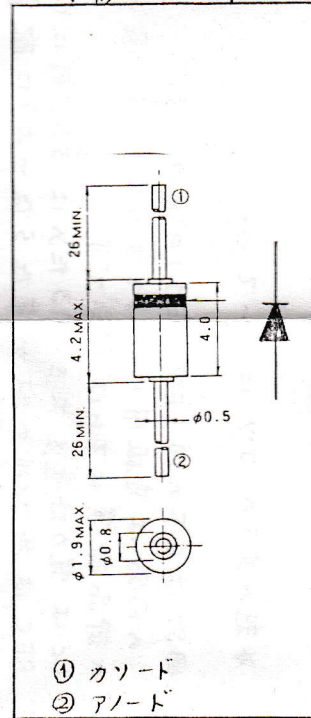
記号	項目	定格値	単位
V _{RM}	せん頭逆電圧	80	V
I _{FSM} *	せん頭順サージ電流	2.0	A
P	許容損失(Ta=25℃)	350	mW
T _j	接合部温度	175	℃
T _{stg}	保存温度	-55~+175	℃

*: t=1sec

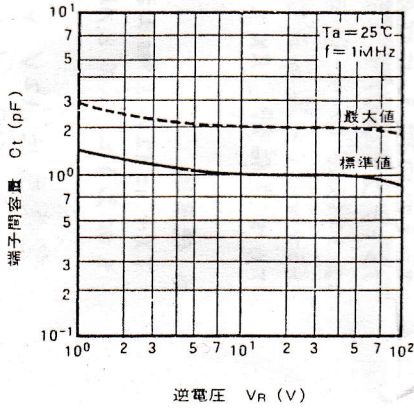
電気的特性 (Ta=25℃)

記号	項目	条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
I _R	逆電流	V _R =60V			150	nA
V _{(BR)R}	降伏電圧	I _R =10μA	80			V
I _F	順電流	V _F =1.0V	100			mA
C _t	端子間容量	V _R =0V, f=1MHz			3.0	pF
r _{fs}	順直列抵抗	I _F =20mA, f=470MHz			1.2	Ω
Q	Q	V _R =0V, f=50MHz	20			—
L _s	直列インダクタンス	総リード長 10mm		2.5		nH

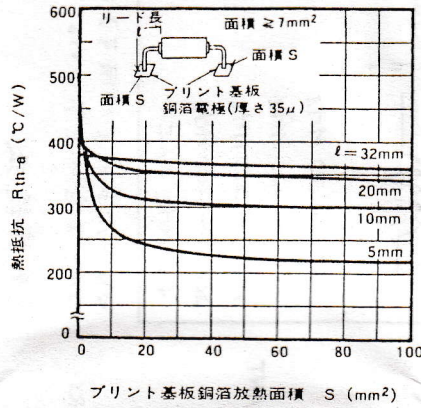
外形図 (単位 mm)



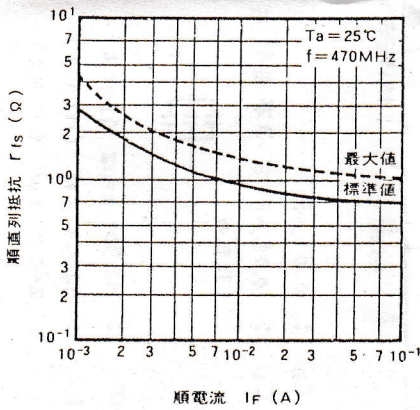
端子間容量—逆電圧特性



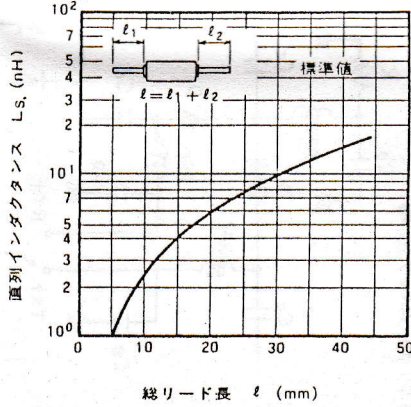
熱抵抗特性



順直列抵抗—順電流特性



直列インダクタンス—総リード長特性



しゃ断周波数—逆電圧特性

